17p-A2-17

過渡電流測定法及び電界誘起光第二次高調波発生法による ITO/Polyimide/C<sub>60</sub>/Al のキャリア挙動の評価と Maxwell-Wagner 効果モデルによる解析

## Study of carrier behavior in ITO/PI/C60/Al using transient current and electricfield-induced optical second-harmonic generation measurements and Maxwell-Wagner model analysis

東工大・理工 〇中村 大二郎・貞方 敦雄・田口 大・間中 孝彰・岩本 光正

Tokyo Tech, Dept. of Phys. Elec, °D. Nakamura, A. Sadakata, D. Taguchi, T. Manaka, M. Iwamoto E-mail: iwamoto@pe.titech.ac.jp

まえがき:二層積層型素子を駆動させた場合、積層界面には Maxwell-Wagner (MW)効果に より界面電荷が形成される。これは電流の応答に大きく影響与えると考えられるため、本実 験ではこの界面電荷の影響を MW モデルの回路計算と実験を用いて解析を行った。MIS 構 造素子(Fig.1:ITO/polyimide (PI)/C<sub>60</sub>/AI)に印加電圧  $V_0$  で PI/C<sub>60</sub> 界面をキャリアで充たした 後 ( $t < t_0$ )、- $V_0 \alpha t$ のランプ波を印加して ( $t \ge t_0$ ) 放電する過程の電流を MW の等価回路モデ ル (Fig.2)を用いて行うと次のようになる。

$$i = -\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V_0 \alpha - \frac{C_1^2}{C_1 + C_2} V_0 \alpha \left( 1 - \exp\left(-\frac{G}{C_1 + C_2}(t - t_0)\right) \right) + \frac{C_1 G}{(C_1 + C_2)^2} (C_1 V_0 - Q_s) \exp\left(-\frac{G}{C_1 + C_2}(t - t_0)\right) \quad (t \ge t_0) \dots (1)$$

$$Q_s = Q_1 - Q_2 = C_1 V_0 \left(1 - \exp\left(-\frac{G}{C_1 + C_2}t\right)\right) \quad (t < t_0) \dots (2)$$

(1)式の第一項は電極充電(放電)の変位電流で、第二項は外部電圧が変化する過程での2層 界面の放電電流、第三項は充電が t<toで不十分だった際の外部電圧による充電電流を表して おり、この項が MW 効果の界面蓄積キャリアによる影響を表している。(2)式より Voによる 充電が十分であるとその際の界面キャリア(Qs)は CVoとなるため、第三項は消え充電によ る電流波形はなくなる。本実験ではこの第三項の影響を実験的に証明し、その際の界面蓄積 キャリアについて評価した。

実験:サンプル構造と実験系を Fig.1 に示す。電圧波形(Fig3 の(A))をサンプルに印加して 過渡電流測定を行い、また C<sub>60</sub>層の電界を測定するため波長 1000 nm のレーザーパルスをサ ンプルに照射し、C<sub>60</sub>層からの波長 500 nm の SH 光強度から C<sub>60</sub>層の電界を測定した。その 結果から界面電荷密度(Q<sub>5</sub>)を評価した。

結果・検討:実験結果を Fig.3 に示す。図の緑の点線は立ち下がりのランプ波の開始するタ イミング ( $t=t_0$ ) である。図の赤線は定電圧  $V_0$ の充電時間 ( $t<t_0$ ) を 50 µs にした測定結果 で、青線は1 ms にした結果である。この結果を比較すると、①の領域での電流値は充電時 間が1 ms の場合( $I_1$ )と比べて 50µs の場合( $I_2$ )が大きいことがわかる ( $I_1 < I_2 < 0$ ) (Fig.3 (B))。 電界誘起光第二次高調波発生法 (EFISHG 法)の測定結果 (Fig3 の(C)) でも領域①で  $Q_s$  (<0) が増加していることがわかる。

結論:充電時間によって変位電流の立ち上がりが遅れることが過渡電流測定と第二次高調 波発生法による実験的手法と MW モデルによる等価回路の回路計算によりわかった。



(A) ΡI  $+O_1$  $C_1$ [×10<sup>-5</sup>] insulator (B)  $-O_1$ -0. Ξ Current  $Q_s$ [×10<sup>-7</sup>]  $+O_2$ (C) $C_2$  $C_{60}$ -On [\_\_\_\_\_] organic Qs [V/ semiconductor 50 μ s 0.6 0.4 0.8 [×10<sup>-3</sup>] Time [s]

Fig.1 ITO/PI/ $C_{60}$ /Al structure sample and experimental.

Fig.2 An equivalent circuit and parameter basedFig.3 (A) Voltage (B) Current.(C) Charge Qson Maxwell-Wagner of ITO/PI/C<sub>60</sub>/Al.remained at the PI/C60 interface.